$$\phi(x) = \frac{qN_A}{2\varepsilon_s}(x + x_p)^2 \quad \stackrel{\text{\tiny def}}{\equiv} -x_p \le x \le 0 \tag{2.15a}$$

同理,在n型區中的電位可求得為:

$$\phi(x) = -\frac{qN_D}{2\varepsilon_s}(x^2 - 2x_n x) + \frac{qN_A}{2\varepsilon_s}x_p^2 \quad \stackrel{\text{def}}{=} 0 \le x \le x_n$$
 (2.15b)

在求得上式的過程中,我們可經由設定當 x=0 (即冶金接面處)時,p型區的電位等於 n型區的電位來決定積分常數。

圖 2-4(c)為通過 p-n 接面空乏區的電位分布。在  $x = -x_p$  處的電位為零;在  $x = x_n$  處,電位的大小等於內建電位  $V_{bi}$ 。由(2.15b)式,可得到:

$$V_{bi} = \frac{qN_Dx_n^2}{2\varepsilon_s} + \frac{qN_Ax_p^2}{2\varepsilon_s}$$
 (2.16)

利用(2.11)式以及整個空乏區的寬度 W 為:

$$W = x_p + x_n \tag{2.17}$$

(2.16) 式可改寫為:

$$V_{bi} = \frac{1}{2} E_m W {(2.18)}$$

亦即,圖 2-4(b)中電場三角形的面積就等於內建電位。

## 2.2.3 空乏區寬度

求空乏區的寬度,我們可先分別決定由冶金接面延伸進入p型區空間電荷區的距離  $x_0$  與n 型區的距離  $x_0$ ,再代入(2.17)式。由(2.12)式,我們有: